ПРОГРАММА

3 февраля 2020 года

09:30-09:40 Открытие семинара

проф. РАН, д.х.н. Д.Н. Дыбцев, ВРИО директора ИНХ СО РАН чл.-к. РАН, проф., д.х.н. В.П. Федин, зав. отделом, ИНХ СО РАН доц., к.х.н. М.Л. Косинова, зав. лабораторией, ИНХ СО РАН

Сессия 1

Фундаментальные основы процессов CVD

Председатель: чл.-к. РАН, проф. В.П. Федин, ИНХ СО РАН, Новосибирск

09:40–10:20 А.Л. Асеев, ИФП СО РАН, Новосибирск

«Полупроводниковые наноструктуры: физика, технология, применения»

Приглашенный доклад

10:20–11:00 С.В. Цыбуля, ИК СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Наноструктуры как продукт самоорганизации неравновесных

состояний»

Приглашенный доклад

11:00–11:20 <u>И.В. Мирзаева</u>, С.Г. Козлова, В.В. Крисюк,

ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Квантовохимическое исследование стабильности димерных комплексов

для газофазного осаждения Cu-Pd плёнок»

11:20-11:40 Кофе/чай

Сессия 2

Фундаментальные основы процессов CVD

Новые исходные вещества для процессов CVD: синтез, очистка и характеризация

Председатель: д.х.н. Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

11:40–12:20 И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Химическое осаждение пленок с позиции термодинамики

неравновесных процессов»

Приглашенный доклад

12:20–12:40 В.В. Лукашов, И.К. Игуменов, ИТ СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Методы описания реагирующего пограничного слоя в CVD процессах»

12:40–13:00 А.А. Тетерина, Е.С. Викулова, А.С. Сухих, С.В. Сысоев,

Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Летучие комплексы Pd(II) с тетрадентатными основаниями шиффа на основе этилендиамина и их применение для синтеза биметаллических

соединений»

13:00 Обед

Сессия 3

Новые направления в развитии технологии CVD

Председатель: проф. РАН, д.х.н. Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

14:00–14:40 В.Ю. Васильев, *НГТУ*, *Новосибирск*

Атомно-слоевое осаждение тонких пленок нитрида кремния и диоксида

кремния (обзор литературных данных)

Приглашенный доклад

14:40–15:20 К.В. Руденко, ФТИАН, Москва
 «Атомно-слоевое осаждение тонких пленок диэлектриков и металлов для перспективных приборов наноэлектроники»
 Приглашенный доклад
 О.Я. Хмель, М.С. Лебедев, ИТ СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск «Низкотемпературный синтез наноразмерных структур SiO_x-TiO₂ для фотокатализа»

15:40–16:00 В.В. Крисюк, *ИНХ СО РАН, Новосибирск* «МОСVD композитных пленок из гетерометаллических прекурсоров»

16:00-16:20 Кофе/чай

Сессия 4

Новые направления в развитии технологии CVD

Председатель: проф., д.х.н. В.Ю. Васильев, НГТУ, Новосибирск

16:20–17:00 В.Я. Принц, ИФП СО РАН, Новосибирск «От планарных структур и приборов к трехмерным и биогибридным» Приглашенный доклад

17:00–17:20 И.С. Меренков, *ИНХ СО РАН, Новосибирск* «Ориентированный рост нанослоев h-BN:С и их свойства»

17:20–17:40 А.В. Мяконьких, И.Э. Клементе, К.В. Руденко *ФТИАН*, *Москва*

«Атомно-слоевое осаждение нитридов титана и тантала с низким электрическим сопротивлением»

17:40–18:00 Р.Р. Нигаард, Ю.А. Осипова, А.Р. Кауль

МГУ. Москва

«Новый подход к дозированию прекурсоров в системах MOCVD и его применение к синтезу тонких пленок h-LuFeO $_3$ и тонкопленочных гетероструктур на его основе»

18:00-18:30 Кофе/чай

4 февраля 2020 года

Сессия 5 Новые направления в развитии технологии CVD Председатель: к.х.н. О.И. Семенова, ИФП СО РАН, Новосибирск		
09:30-10:10	А.В. Двуреченский, А.И. Якимов, В.В. Кириенко, А.А. Блошкин, А.Ф. Зиновьева, А.В. Ненашев, В.А. Зиновьев	
	ИФП СО РАН, НГУ, Новосибирск	
	«Кремниевые наноструктуры с квантовыми точками сопряженные с композитными металл-диэлектрическими метаповерхностями»	
	Приглашенный доклад	
10:10-10:30	П.А. Коренев, А.В. Масюк, Д.А. Величко ООО «СЕРНИЯ-Инжиниринг», Москва	
	«Выращивание алмазных пластин высокой чистоты методом MW- PACVD в микроволновом плазменном реакторе PLASSYS SSDR150»	
10:30-10:50	А.А. Емельянов, А.К. Ребров, <u>Н.И. Тимошенко</u>, И.Б. Юдин <i>ИТ СО РАН, Новосибирск</i>	
	«Газоструйный синтез алмазных структур с СВЧ активацией газов предшественников»	
10:50-11:10	А.А. Емельянов, М.Ю. Плотников, <u>И.Б. Юдин</u>	
	ИТ СО РАН, Новосибирск	
	«Зондовая подача метана при газоструйном HW CVD синтезе алмазных	
	структур»	
11:10–11:40	Кофе/чай	
_	алы и сложные структуры, полученные в процессах CVD проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва	
Новые материа	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва <u>Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих</u>	
Новые материа Председатель:	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва <u>Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих</u> <i>ИНХ СО РАН, Новосибирск</i>	
Новые материа Председатель:	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических	
Новые материа Председатель:	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва <u>Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих</u> <i>ИНХ СО РАН, Новосибирск</i>	
Новые материа Председатель:	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов,	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва «Структура диэлектриков на основе атомно-осажденных оксидов	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва «Структура диэлектриков на основе атомно-осажденных оксидов гафния-циркония в скрытых слоях КНИ и КНС» А.А. Спирина, Н.Л. Шварц, ИФП СО РАН, НГТУ, Новосибирск «Анализ CVD роста планарных нанопроволок GaAs по механизму пар-	
Новые материа Председатель: 11:40–12:20 11:40–12:20	проф., д.фм.н. К.В. Руденко, ФТИАН, Москва Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих ИНХ СО РАН, Новосибирск «Фталоцианины металлов в качестве активных слоев химических сенсоров» Приглашенный доклад В.П. Попов, В.А. Антонов, А.В. Мяконьких, А.А. Ломов, К.В. Руденко ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва «Структура диэлектриков на основе атомно-осажденных оксидов гафния-циркония в скрытых слоях КНИ и КНС» А.А. Спирина, Н.Л. Шварц, ИФП СО РАН, НГТУ, Новосибирск	

	иалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD : доц., к.х.н. М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
14:00–14:20	Е.В. Шляхова, Ю.В. Федосеева, Е.В. Лобяк, А.В. Окотруб, Л.Г. Булушева, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск «Синтез азот-допированого пористого углеродного материала из ацетонитрила и солей кальция (тартрат, адипинат, глугарат)»
14:20–14:40	О.В. Седельникова, О.А. Гурова, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб ИНХ СО РАН, Новосибирск «Строение и электронная структура серы и сульфида мышьяка,
14:40–15:00	инкапсулированных в углеродных нанотрубах» В.Р. Шаяпов, О.В. Маслова, М.Л. Косинова ИНХ СО РАН, Новосибирск «Химический состав плазмы в процессах плазмохимического осаждения пленок из паров 1,4-бис(триметилсилил)-пиперазина
15:00–15:20	и 4-(триметилсилил)морфолина» <u>А.Г. Плеханов</u> , Н.И. Файнер , <i>ИНХ СО РАН</i> , <i>Новосибирск</i> «Синтез аморфных пленок SiC _x N _y Fe _z плазмохимическим разложением газовой смеси 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазана, ферроцена и гелия»
15:20–15:40	В.Н.Демин, Т.П. Смирнова, В.О. Борисов, Г.Н. Грачев, А.Л.Смирнов, М.Н. Хомяков, ИНХ СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск «Лазерно-плазмохимическое осаждение пленок карбонитрида кремния
15:40–16:00	из паров гексаметилдисилазана и смеси (ГМДС + бензол)» <u>В.С. Суляева</u> , М.Л. Косинова , <i>ИНХ СО РАН</i> , <i>Новосибирск</i> «Низкотемпературный синтез плёнок SiC_xN_y методом реактивного магнетронного распыления»
16:00–16:20	Кофе/чай
	иалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD: д.х.н. Н.В. Гельфонд, ИНХ СО РАН, Новосибирск
16:20–16:40	М.С. Лебедев, <i>ИНХ СО РАН</i> , <i>Новосибирск</i> «Различные маршруты атомно-слоевого осаждения тонких пленок $Hf_{1-x}Ti_xO_2(0 \le x \le 1)$ и многослойных структур $N*(HfO_2/TiO_2)$ »
16:40–17:00	С.В. Белая, В.В. Баковец, М.И. Рахманова, И.В. Юшина, Е.А. Максимовский, И.В. Корольков, В.Р. Шаяпов ИНХ СО РАН, Новосибирск «CVD пленки (Gd _{1-x} Tb _x) ₂ O ₂ S и их оптические свойства»
17:00–17:20	<u>Н.С. Николаева</u> , Д.Е. Тряхов, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск «Гетероструктуры на основе фталоцианинов металлов и наночастиц Pd, Au: получение методами газофазного осаждения и исследование
17:20–17:40	структурных особенностей» <u>В.В. Лозанов</u> , Н.Б. Морозова, Н.И. Бакланова <i>ИХТТМ СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск</i> "Особенности взаимодействия иридия, полученного методом МОСVD, с
17:40–18:00	карбидами переходных металлов" <u>C.A. Сосновский</u> , Hongda Li <i>СФТИ ТГУ, Томск, Shenyang Ligong University, Shenyang</i> «Термодинамическое моделирование и экспериментальное исследование
18:00-19:00	процессов осаждения плёнок In_2O_3 , Dy_2O_3 , $DyInO_3$ из газовой фазы» Стендовая сессия. Кофе/чай

Стендовая сессия

1. Р.Р. Нигаард, М.Н. Маркелова, А.С. Шуркина, Д.М. Цымбаренко, А.Р. Кауль

МГУ, Москва

«Моделирование интерфейсов тонких пленок $LuFeO_3$ на монокристаллических подложках YSZ различной ориентации»

2. В.А. Шестаков, В.И. Косяков, М.Л. Косинова

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Обобщенная CVD-диаграмма системы Si-C-N-H-He(Ar)»

3. А.М. Макаренко, К.В. Жерикова, А.М. Игошкин

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Термохимия предшественников MOCVD: структура-свойство»

4. К.И. Караковская, Е.С. Викулова, И.Ю. Ильин, Л.Н. Зеленина,

С.В. Сысоев, Н.Б. Морозова

ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Летучие комплексы иридия (I) с β-дикетонами и карбонилами: синтез и исследование термических свойств»

5. А.Ю. Стручевская, К.В. Жерикова, Е.С. Викулова, Н.В. Куратьева, С.В. Забуслаев

ИНХ СО РАН, НГУ, АО «Катод», Новосибирск

«MOCVD предшественники циркония, церия и иттрия: синтез, кристаллохимическое и термическое исследования»

6. П.А. Стабников, Н.В. Первухина, Н.В. Куратьева, И.В. Корольков,

С. Уркасым Кызы, С.В. Крисюк, С.В. Сысоев

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Новая фаза летучих прекурсоров трис-дипивалоилметанатов лантаноидов»

7. А.Д. Асмедьянова, Е.С. Викулова, И.Ю. Ильин, А.И. Смоленцев,

Т.С. Сухих, Н.Б. Морозова

НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Синтез и характеризация гомо- и гетеролигандных комплексов серебра (I) со фторированными β-дикетонами»

8. В.В. Соколов, И.Ю. Филатова, Б. М. Кучумов

ИНХ СО РАН, НГТУ, Новосибирск

«Новый источник для получения карбонитридных слоёв и упрочнения поверхности материалов»

9. Д. Е. Петухова, М.С. Лебедев

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Влияние состава на структуру и свойства тонких пленок $Sc_xTi_{1-x}O_y$, полученных методом атомно-слоевого осаждения»

10. Ф.Я. Акбар, Д.И. Шароваров, О.В. Бойцова, А.Р. Кауль

МГУ, Москва

«Получение тонкопленочных материалов системы диоксидов ванадия и титана методом MOCVD»

11. А.Е. Щукин, А.Р. Кауль

МГУ, Москва

«Многослойные сверхпроводящие гетероструктуры $YBCO/Y_2O_3$, полученные методом MOCVD»

12. А.Д. Нищакова, М.А. Гребёнкина, А.В. Окотруб, Л.Г. Булушева

ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Влияние температуры CVD синтеза на структуру и свойства пористого азотсодержащего углеродного материала»

13. <u>А.А. Федосова</u>, М.А. Гребенкина, А.Д. Нищакова, Е.В. Шляхова, Ю.В. Федосеева, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб

ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Влияние температуры CVD-синтеза пористого азотсодержащего углеродного материала на электрохимические свойства в натрий-ионных аккумуляторах»

14. В.Р. Кузнецова, Е.В. Лобяк, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб

ИНХ СО РАН, НГТУ, Новосибирск

«Электрохимические свойства гибридных материалов на основе пористого углерода и углеродных нанотрубок, полученных CCVD-методом»

15. Д.В. Бонегардт, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих, Т.В. Басова

«Синтез, характеризация и исследование сенсорных свойств галогензамещенных фталоцианинов цинка $ZnPcX_4$ (X = F, Cl, I)» *ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск*

16. А.А. Ворошнина, И.С. Меренков

ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

«Разработка методик синтеза допированных кислородом наностенок h-BN»

17. М.Н. Чагин, И.В. Юшина, В.Р. Шаяпов, М.Л. Косинова

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Оптические свойства пленок, образующихся из паров тетраметилдисилазана в реакторе с индуктивно связанной плазмой»

18. Н.И. Файнер, А.Г. Плеханов

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Получение высокопрозрачных пленок $SiC_xN_yO_z$:Н плазмохимическим разложением газовой смеси кремнийорганических соединений, кислорода и азота»

19. М.Н. Чагин, А.Н. Колодин, В.С. Суляева, М.Л. Косинова

ИНХ СО РАН, Новосибирск

«Влияние температуры ICP CVD-синтеза на состав и свойства поверхности пленок SiC_xN_y :H, сформированных из смесей тетраметилдисилазана с аргоном и азотом»

20. С.А. Сосновский, Hongda Li

СФТИ ТГУ, Томск, Shenyang Ligong University, Shenyang

«Термодинамическое моделирование и экспериментальное исследование процессов осаждения плёнок W и S из газовой фазы при воздействии импульсного электронного пучка»

5 февраля 2020 года

Сессия 9 Диагностика пленок и покрытий, контроль процессов CVD Председатель: д.х.н. И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск		
09:30-10:10	Э.М. Мороз, ИК СО РАН, Новосибирск «Метод PDF для определения фазового состава и локальной структуры наноматериалов (обзор)» Приглашенный доклад	
10:10-10:50	О.И. Семенова, К.П. Могильников, ИФП СО РАН, Новосибирск «Метод измерения пористой структуры тонких диэлектрических слоев» Приглашенный доклад	
10:50-11:10	В.Н. Кручинин, М.С. Лебедев ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск «Оптические свойства пленок простых и смешанных оксидов, полученных методом атомно-слоевого осаждения»	
11:10–11:40	Кофе/чай	
	иенок и покрытий, контроль процессов CVD ц.х.н. В.В. Баковец, ИНХ СО РАН, Новосибирск	
11:40–12:20	Е.Я. Гатапова , <i>ИТ СО РАН</i> , <i>Новосибирск</i> «Методы определения свойств смачивания поверхностей» Приглашенный доклад	
12:20-12:40	А.Н. Колодин, В.С. Суляева, П.С. Поповецкий ИНХ СО РАН, Новосибирск «Исследование шероховатости пленок на основе органозолей наночастиц Ад с модифицированной поверхностью методом определения краевых углов смачивания»	
12:40-13:00	М.Н. Хомяков, <i>ИЛФ СО РАН, Новосибирск</i> «Определение физико-механических свойств тонких пленок при помощи сканирующего нанотвердомера НАНОСКАН-3D»	
13:00	Обед	
Сессия 11 Применение пр Председатель: г	оцессов CVD проф., д.х.н. И.К. Игуменов, ИНХ СО РАН, Новосибирск	
14:00-14:40	Н.И. Бакланова , <i>ИХТТМ СО РАН</i> , <i>Новосибирск</i> "Возможности химического материаловедения в решении проблем получения карбидокремниевых композиционных материалов» Приглашенный доклад	
14:40–15:00	С.И. Доровских, Н.Б. Морозова ИНХ СО РАН, Новосибирск «Особенности роста Рt слоев с развитой структурой на контактах медицинских электродов»	
15:00–15:20	Т.М. Залялов, М.С. Лебедев, Д.Р. Исламов НГУ, ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск «Получение плёнок оксида гафния с низкими токами утечек для	

приборов микроэлектроники субмикронных размеров»

15:20-15:40 В.П. Попов, В.А. Антонов, Ф.В. Тихоненко, А.В. Мяконьких, К.В. Руденко, ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН, Москва «Электронные свойства КНИ структур с атомно-осажденными на кремний изолирующими слоями оксида гафния и циркония» 15:40-16:00 М.В. Катков, М.С. Лебедев, В.Р. Шаяпов, Г. Айвазян ИНХ СО РАН, Новосибирск, НПУА, Ереван «Антиотражающие свойства «черного» кремния при пассивации его поверхности методом атомно-слоевого осаждения: моделирование и эксперимент» 16:00-16:20 Кофе/чай Сессия 12 Применение процессов CVD Председатель: проф., д.х.н. Н.И. Бакланова, ИХТТМ СО РАН, Новосибирск 16:20-16:40 Д.И. Шароваров, А.Р. Кауль, МГУ, ООО «Оксифилм», Москва «Разработка оборудования для получения функциональных покрытий методом химического осаждения из газовой фазы» 16:40-17:00 Д.В. Горшков, Е.С. Викулова, С.С. Бадулин, С.В. Забуслаев, Б.М. Кучумов, И.Г. Васильева, И.К. Игуменов ООО «Катод», ИНХ СО РАН, Новосибирск «Модификация поверхности каналов стеклянных невосстановленных микроканальных пластин методом импульсного MOCVD» 17:00-17:20 В.Р. Шаяпов, И.С. Меренков, К.В. Захарченко, М.Н. Хомяков ИНХ СО РАН, ИГИЛ СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск «Механические свойства и износостойкость защитных покрытий карбонитрида бора, полученных методом химического осаждения из газовой фазы» А.Л. Богословцева, А.И. Сафонов, ИТ СО РАН, Новосибирск 17:20-17:40 «Осаждение фторполимерных пленок на поверхности вращающихся трубок методом HW CVD» 17:40-18:00 Закрытие семинара

Кофе/чай